

# 國立成功大學智慧半導體及永續製造學院半導體封測學位學程 論文發表認定原則

112 年 2 月 8 日 111 學年度第 2 學期第 1 次學程業務會議通過

112 年 4 月 10 日 111 學年度第 6 次院務會議備查

一、國立成功大學智慧半導體及永續製造學院半導體封測博士學位學程（以下簡稱本學程），為辦理本學程博士生發表與研究相關之國際學術論文或發明專利之認定，依國立成功大學智慧半導體及永續製造學院半導體封測博士學位學程修業辦法第六條第二項規定，訂定本原則。

二、本學程所稱國際學術論文認定標準如下：

(一)須為發表於 SCI 相關領域、影響係數(Impact factor)領域排名(JCI)Q2(含)以前之期刊(領域排名可擇優)，排名及影響係數之認定，以論文投稿日當年度或前五年度所公布之 ISI 資料庫排名及影響係數為準，但提出申請時之論文需為”已接受”，且：

1.各期刊論文係以「Original Article」、「Research Article」、「Letter」、及「Review Article」為標準，不含「Letter to Editor」、「Comment」及「研討會論文(Proceedings Paper)」等。各期刊之等級(rank)認定方式以發表當年或前一年 Journal Citation Reports(JCR)資料庫之 rank 數值為原則。

2.除指導教授、共同指導教授外，研究生應為第一作者；除本款第 3 目之特殊原因外，隸屬單位(affiliation) 應僅列 Program on Semiconductor Packaging and Testing, Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing, National Cheng Kung University。

3.論文通訊作者應為指導教授，且列本校為服務單位(affiliation)之一。

(二)論文發表在無明顯標示通訊作者之期刊時，應檢附指導教授為通訊作者之證明。

(三)論文發表前，研究生有下列各目情形之一，可增(共)列隸屬單位：

1.與校內各級單位、中心以上簽有正式合作備忘錄或意向書等單位合作，並有支領對方經費者；

2.與簽准共同指導教授之單位合作，並有支領對方經費者；

3.以在職生身分入學者，可共列其工作單位；

(四)已抵免之論文，不計入畢業所須論文數。

(五)論文有多人相同貢獻第一作者時，則貢獻權重均分之，可累計發表論文數加總貢獻權重達一篇。

三、本學程所稱發明專利認定標準如下：

(一)須於入學後不含休學之六學期內獲核准之發明專利。

(二)專利發明人應包含博士生本人及其指導教授。

(三)專利所有權所屬單位須為本校，若專利所有權非本校屬產學合作單位，則須檢附合約佐證。

(四)已抵免之專利，不計入畢業所須論文或專利數。

(五)專利題目應與其博士學位論文相關。

(六)專利申請日期應為就讀本校期間。

四、本原則經本學程會議通過後實施，送院務會議備查，修正時亦同。